

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	超高速 SiGe デバイス材料技術調査 専門委員会 (C部門) 【電子材料技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成14年2月～平成16年1月	次世代情報通信・処理デバイ スを実現する上で SiGe 材料 の応用はきわめて重要であ る。このため、SiGe 極限ヘテ ロ構造形成等の材料基盤技 術、超高速・低消費電力 SiGe デバイス技術、回路設計・デ バイス応用技術に関して、組 織的な調査・検討を行う。	
委員長名(所属)	室田 淳一 (東北大学)		
委員会開催頻度	4回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		室田 淳一 (東北大学)
	電話		022-217-5548
	FAX		022-217-5548
	E-mail ア ドレス		<a href="mailto:murota@riec.tohoku.ac.jp">murota@riec.tohoku.ac.jp</a>
応募いただきたい 方の専門分野, 経験など	SiGe 系デバイス材料の基礎とその デバイス応用分野に従事または興 味を持っている方。電気学会会員あ るいは入会していただける方が望 ましい。		
公募締切	平成14年2月末日		